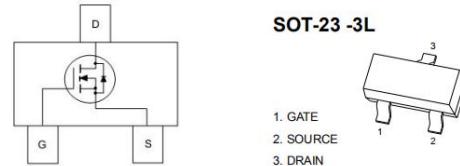


FS3404

SOT-23-3L 場效應晶體管(SOT-23-3L Field Effect Transistors)



N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	30	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	I_D	5.8	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脈沖	I_{DM}	20	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 TA=25°C 環境溫度為 25°C	P_D	1500	mW
Junction 結溫	T_J	150	°C
Storage Temperature 儲存溫度	T_{stg}	-55 to +150	°C

■ DEVICE MARKING 打標

FS3404=A4LA

FS3404

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

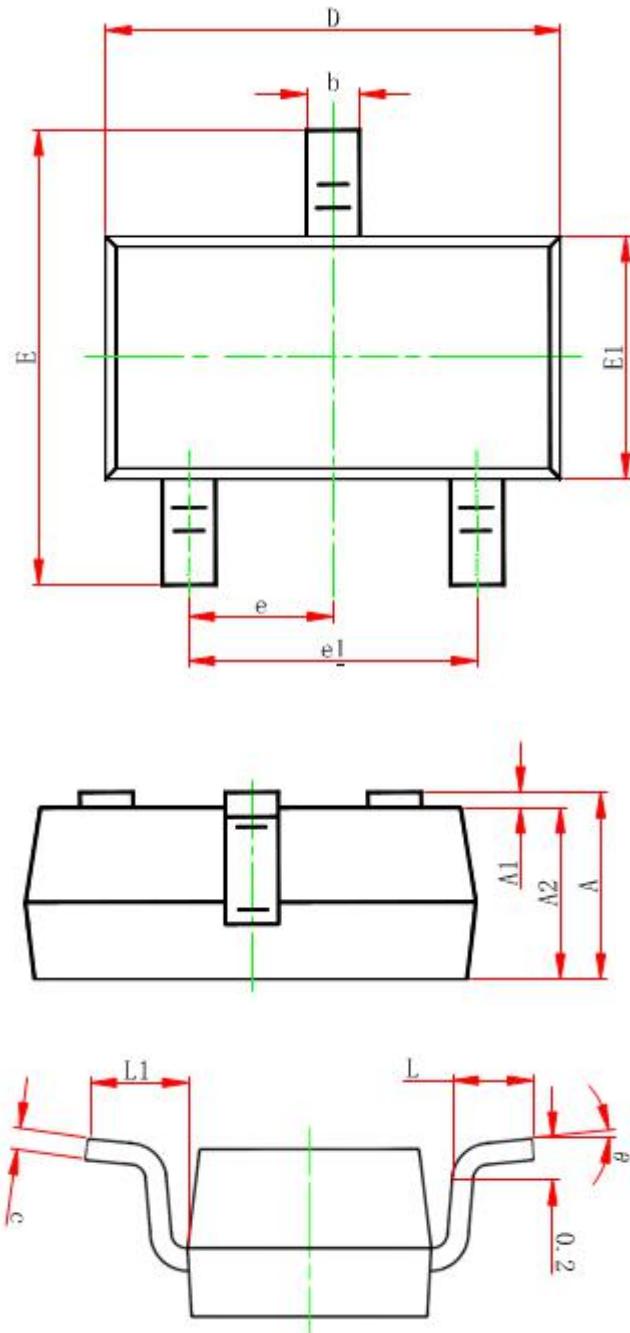
Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=250\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	30	32	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啟電壓($I_D=250\mu\text{A}$, $V_{GS}= V_{DS}$)	$V_{GS(\text{th})}$	1	—	3	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_S= 1\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	0.7	1	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}= 30\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=+20\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻($I_D= 5\text{A}$, $V_{GS}=10\text{V}$)	$R_{DS(\text{ON})}$	—	24	28	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻($I_D= 3\text{A}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$)	$R_{DS(\text{ON})}$	—	38	45	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}= 15\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	540	—	pF
Output Capacitance 輸出電容 ($V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}= 15\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	60	—	pF
Turn-ON Time 开启時間 ($V_{DS}= 15\text{V}$, $V_{GS}= 10\text{V}$, $R_{GEN}=6\Omega$)	$t_{(\text{on})}$	—	9.5	—	ns
Turn-OFF Time 关斷時間 ($V_{DS}= 15\text{V}$, $V_{GS}= 10\text{V}$, $R_{GEN}=6\Omega$)	$t_{(\text{off})}$	—	36	—	ns

Pulse Width $\leq 300 \mu\text{s}$; Duty Cycle $\leq 2.0\%$

FS3404M

■DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代码	范围(单位: mm)
A	1.050~1.250
A1	0.000~0.100
A2	1.050~1.150
b	0.300~0.500
c	0.100~0.200
D	2.820~3.020
E1	1.500~1.700
E	2.650~2.950
e	0.950(BSC)
e 1	1.800~2.00
L	0.300~0.600
L1	0.600REF.
θ	0°~8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for MOSFET category:

Click to view products by FOSAN manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [AOD464](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#)
[405094E](#) [423220D](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [SSM6J414TU,LF\(T\)](#) [751625C](#) [BSC884N03MS G](#) [BSF024N03LT3 G](#)
[PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-](#)
[7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#)
[SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#)
[C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IRF40SC240ARMA1](#)
[IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)